# 메디치 프로그램을 이용한 실리콘 솔라셀의 ARC 두께에 따른 전기적 특성 해석

김재규<sup>1</sup>, 김지만<sup>2</sup>, 송한정<sup>1\*</sup> <sup>1</sup>인제대학교 나노공학부, <sup>2</sup>인제대학교 나노시스템공학과

## Analysis of Electrical Characteristics of Silicon Solar cell according to the ARC thickness using Medici Program

## Jae-Gyu Kim<sup>1</sup>, Ji-Man Kim<sup>2</sup> and Han-Jung Song<sup>1\*</sup> <sup>1</sup>Department of Nano Eng., Inje University <sup>2</sup>Department of Nano Systems Eng., Center for Nano Manufacturing

**요 약** 본 논문에서는 메디치 프로그램을 사용하여 반사방지막(ARC : anti reflectance coating) 두께에 따라 실리콘 솔라셀의 전기적 특성분석을 보여준다. ITO 투명전극으로 이루어지는 ARC를 이용한 실리콘 솔라셀의 메쉬구조를 구축하고 ARC 두께에 따른 특성해석 모델링을 실시하였다. ARC 산화층의 두께가 30 nm, 60 nm. 90 nm일 때 입사 광의 파장에 따른 외부 수집 효율성, 투과율, Isc, Voc, I-V 특성 변화 등을 구하였다. 시뮬레이션 결과 60 nm의 반 사방지막 두께에서 최대전력 22 mW/cm<sup>2</sup>, 0.83의 곡선 인자를 보였다.

**Abstract** This paper shows electrical analysis of the silicon solar cell according to the various ARC thickness using Medici program. we built a mesh structure of the solar cell that use ARC consisting of ITO(Indium-Tin-Oxide) transparent electrode, for the Medici modeling. About various oxide layer thickness of the ARC for 30 nm, 60 nm, 90 nm, changes of the I-V curve, Isc, Voc, transmittance and external collection efficiency performed according to wavelength of Incident ray.

Simulation results show maximum power 22 mW/cm<sup>2</sup>, fill factor 0.83 in condition of 60 nm ITO thickness.

Key Words : ARC, Wavelength, Medici, transmittance, External collection efficiency

### 1. 서론

청정에너지의 대표적인 솔라셀은 제조기술의 발달과 더불어 여러 가지 형태의 고효율 솔라셀 구현이 가능해 지면서, 그 활용가능성이 갈수록 증대하고 있다. 이러한 고효율의 태양전지를 만들기 위해서는 최대한 많은 빛을 흡수 할 수 이것이 중요하다. 빛의 반사를 줄이는 방법으 로 Texturing, Anti reflectance coating, 정교한 pn접합 등 이 있다. Texturing 기술로는 전체 입사된 빛의 약 10%정 도로 반사를 줄일 수 있으며,[1,2] Anti reflectance coating 으로 표변 반사를 줄이기 위해서는 반도체 표면에 투명 하고, 굴절률이 반도체와 공기의 사이 값을 갖는 박막 층 을 적당한 두께로 만들어 주며, 이때 박막 층을 반사방지 막이라고 한다. 특히 유리나 금속판재와 같은 저가의 기 판에 박막재료를 코팅하여 제조하는 박막(셀)형 태양전 지는 대면적 양산화를 통한 저가격화 실현이 가능한 차 세대 태양전지로 업계의 많은 관심을 끌고 있다.[3] 본 논 문에서는 광 투과성 도전박막으로 가시광선에서의 투광 성이 높으며 전기전도도 또한 높은 ITO를 반사 방지막으 로 사용하였다. 그리고 이 박막을 사용하여 전기 에너지

본 논문은 IDEC(IC Design Education Center)의 지원으로 이루어졌음.

<sup>\*</sup>교신저자 : 송한정(hjsong@inje.ac.kr)

접수일 10년 06월 07일 수정일 (1차 10년 08월 06일, 2차 10년 08월 17일, 3차 10년 10월 04일) 계재확정일 10년 10월 15일

변환효율의 향상과 제조단가 저하가 주관심이고 이를 위 해 제조공정을 거치기 전에 모의실험을 하여 변환효율의 특성을 확인할 필요가 있다.[5] 따라서 본 논문에서는 반 도체 소자 분석용 메디치 프로그램을 이용하여, ITO 산 화충의 반사방지막을 갖는 실리콘 솔라셀의 전기적 특성 분석을 하고자 한다. II장에서 ITO 반사방지막을 갖는 실 리콘 솔라셀 구조를 소개하고, III장에서 메디치 모델링 을 위한 ITO 전극구조의 솔라셀 메쉬 구현을 보인다. IV 장에서 ITO 반사방지막의 두께에 따른 솔라셀의 I-V 특 성, Isc, Voc, 최대전력, 곡선 인자 특성해석을 실시하고 마지막으로 결론을 내린다.

#### 2. ITO 투명전극 구조의 실리콘 솔라셀

그림 1은 본 논문에서 두께에 따라 분석하고자 하는 ITO 투명전극의 구조 및 AFM(Atomic force microscope : 원자현미경)으로 측정한 표면결과를 보이고 있다. 빛의 반사를 줄이기 위해 표면을 매끄럽게 하지 않고 거칠게 만들며 그로 인해 빛 에너지를 전기 에너지로 바꿀 수 있 는 효율성이 높아진다.



[그림 1] ITO 셀의 모습 (a) 기본모델, (b) AFM에 의 해 ITO 표면을 나타낸 모습

그림 1 중에서 (a)는 ITO를 박막으로 하고 결정질 실 리콘을 기본으로 한 구조이다. 박막 위에 유리 같은 재료 를 놓은 전형적인 구조이다. (b)는 n층 위에 박막이 Texturing을 이용해 표면을 거칠게 하여 실리콘 솔라셀의 기판 표면에서 반사되어 없어져 버리는 손실분을 줄여 줄 수 있다.



[그림 2] ITO 투명전극을 갖는 실리콘 솔라셀 기본 구조

그림 2는 실리콘 솔라셀의 기본 구조를 나타낸 것이고 그림 3에 본 논문에서 분석하고자 하는 ITO 투명전극 구 조의 결정질 실리콘 솔라셀의 전기적인 등가회로를 나타 내고 있다.



[그림 3] ITO 투명전극을 갖는 실리콘 솔라셀 전기적 등가 회로

## ITO 투명전극 구조의 실리콘 솔라셀의 메디치 모델링

그림 4는 메디치 프로그램을 이용하여 전기적 특성분 석을 위하여 구성한 실리콘 솔라셀의 메쉬 형태를 보인 다. 결정질 실리콘의 기본 모식도를 메디치를 표현하기 위하여 대표적인 pn 접합구조를 선택하였다. 여기서 산 화층은 ITO 즉 투명전극이고 중심은 도핑(n층) 그리고 아래 부분은 기판(p층)이다. p층은 기판층으로 전자를 주 는 역할을 하고 n층은 불순물 도핑으로서 나타낸다. 본 구조를 통하여 ITO의 두께에 따른 솔라셀의 빛의 강도와 전압 전류의 특성 관계 그리고 투과율과 외부 수집 효율 성 등에 대해서 알아본다.



[그림 4] ITO 반사방지막을 갖는 실리콘 솔라셀의 특성해 석을 위한 메쉬 구조

ITO는 투명전극으로 사용되어지는 광 투과성 도전박 막으로서 가시광선에서의 투광성이 높으며 전기전도도 또한 매우 높다. 이러한 ITO 박막의 두께와 파장에 따라 투과율(transmittance)이 다르기 때문에 이 조건들을 충족 시키는 것은 매우 중요하다. 여기서. ITO의 모델링 이름 을 Tox(산화두께)라고 지정하고 두께를 30 nm, 60 nm, 90 nm으로 하는 세 가지 조건과 함께 파장을 20 nm부터 1000 nm까지 투과율의 변화를 메디치 프로그램을 이용 하여 ITO의 투과율, 단락회로 전류, 외부 수집 효율성 등 세 가지의 모델을 만들어 보았다. 이 모델을 만들기 위한 과정은 모두 3단계로 나누어지는데 ASSGIN, PLOT, LABEL 이다. ASSIGN은 이름과 값을 지정해주고 PLOT 은 축의 이름 등을 지정해 준다. 그리고 LEBEL은 색깔이 나 그래프의 이름을 붙여 준다. 그림 5는 투명전극을 갖 는 결정질 실리콘 솔라셀의 메디치 프로그램 분석 파라 미터 모델을 나타낸다. 여기서 메디치 프로그램 장점은 반사방지막의 두께를 조절하기 위한 다른 절차 없이 수 치만 바꿔 넣으면 그 수치에 따른 특성변화를 알 수 있다 는 것이다.

```
TITLE
                  Plot results of silicon solar cell
MESH
                   IN. FILE=SSMSH2
PLOT. 2D
                               "Tox=0.06 Microns" GRID FILL BOUND REGION
                   TITLE
                    SCALE
                   Transmittance of the ITO
STEPS=3
NAME=TOX N.VALUE=(0.
COMMENT
LOOPS
   ASSIGN
                                            N. VALUE=(0.03.0.06.0.09)
                      NAME-LI N.VALUE-(1.2.3)
NAME-LEAR C1=CLEAR C2=CLEAR C3=CLEAR
IN.FILE="MDEX19.SPL"@L1 X.AXIS=WA Y.AXIS=TR
COLOR=@L1 SYMB=@L1 LEFT=0.2 RIGHT=1.0
   ASSIGN
    ASSIGN
    PLOT.1D
                      BOT=0.2
                                       TOP=1
                                                  @CLEAR
                      TITLE="MDEX19B Transmittance -vs- Wavelength"
LABEL="Tox="@TOX" Microns" COLOR=@L1 SYMB=@L1
   LABEL
                      X=0.6 Y=0.3+@L1/25 C.SIZE=0.3
L.END
COMMENT
                   Short-Circuit Current
LOOPS
                   STEPS=3
   ASSIGN
                      NAME=TOX
                                            N.VALUE=(0.03,0.06,0.09)
                      NAME=TOX N.VALUE=(0.03,0.05,0.09)
NAME-LI N.VALUE=(1,2,3)
NAME-CLEAR C1=CLEAR C2=^CLEAR C3=^CLEAR
IN.FILE="MDEX19.SPL"@LI X.AXIS=WA Y.AXIS=I(1) ABS
COLOR=@LI SYMB=@LI @CLEAR BOT=0 TOP=0.3E-11
TITLE="MDEX19B Short C1rcuit Current -vs- Mavelength"
LABEL="Tox="@TOX" Microns" COLOR=@LI SYMB=@L1
X=0.25 Y=2.0E-12+@L1*1.5E-13
   ASSIGN
   PLOT.1D
   LABEL
L.END
COMMENT
                   External Collection Efficiency
LOOPS
                   STEPS=3
   ASSTON
                      NAME=TOX
                                            N. VALUE=(0.03.0.06.0.09)
                      NAME=L1
NAME=CLEAR
                      NAME=IOX N.VALUE=(0.03,0.05,0.05)
NAME=CLEAR C1=CLEAR C2=^CLEAR C3=^CLEAR
IN.FILE="MDEX19.SPL"@L1 X.AXIS=WA Y.AXIS=CE(1) ABS
COLOR=@L1 SYMB=@L1 @CLEAR BOT=0 TOP=100
   ASSIGN
   PLOT.1D
                      TITLE="MDEX19B External Collect. Efficient
LABEL="TOX="@TOX" Microns" COLOR=@L1 SV
X=0.5 Y=15+@L1*5 C.SIZE=0.3
                                                                                             ciency"
SYMB=@L1
   LABEL
L.END
```

[그림 5] ITO 투명전극을 갖는 실리콘 솔라셀의 파라미터 모델

## 4. ITO 투명전극 구조의 솔라셀 메디치 해석 결과

그림 6을 보면 박막의 두께가 두꺼울수록 높은 파장대 에서 투과율이 높은 것을 알 수 있다. 여기서 박막의 두 께에 따른 투과율을 살펴보면 최고 투과율을 나타나는 파장에서 90 nm의 두께를 가진 박막이 가장 높은 파장을 나타내었다. 그리고 상대적으로 중간 파장에서 최고 투과 율을 보이는 것은 60 nm이고 파장이 가장 짧은 곳에서 최고 투과율을 보이는 것은 박막의 두께가 30 nm인 것으 로 나타났다. 즉 두께가 두꺼울수록 긴 파장의 빛에서 높 은 투과율을 보였다.



[그림 6] ITO두께와 파장에 따른 투과율 변화

단락회로에서는 60 nm ITO 셀에서 최고 전류값을 보 여주고 있다. 여기서 대체적으로 투과율 특성과는 비슷하 게 나타났으나 파장의 크기 차이는 투과율을 측정할 때 보다 크지 않았다. 그리고 전류에 따른 외부 수집 효율성 은 전하량을 측정된 셀의 표면위에 입사된 광자 수에 의 해 나누어지는 파장에서 전체 광전류 밀도  $J(\lambda)$ 로서 정 의 되어진다. 이것은 소자 안에서 광 생성되는 전자-정공 쌍 발생속도인 양자효율과는 다르다. 단락회로, 외부 수 집 효율성(External collection efficiency)에서 30 nm ITO 셀이 다른 두께를 가진 두 셀보다 훨씬 더 낮게 나타났는 데 이것은 파장이 400 nm 이후에 투과율이 좋지 않기 때 문이다. 그림 8에서 60 nm ITO 셀은 관련된 대부분의 태 양에너지의 파장범위(가시광선)인 400 nm에서 700 nm까 지 가시광선 영역에서 가장 높은 효율을 보여주고 있다.







솔라셀은 빛에너지를 전기에너지로 변환시키고 다이 오드는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 소 자로서 정반대 개념이지만 pn접합을 이용하여 변환시키 므로 비슷한 전압-전류 특성 곡선을 가진다. 이 솔라셀의 전압-전류 특성 곡선은 암 상태에서의 다이오드 전류-전 압 곡선에 광생성 전류를 중첩시키면 된다. 즉, 암 상태에 서의 다이오드 전압-전류 곡선을 아래쪽으로 광생성 전 류만큼 이동시키면 된다.

그림 9는 ITO 셀의 두께에 따라 광생성 전류만큼 이동 시킨 것이다. 이 때 다이오드 방정식은 다음과 같이 주어 진다.

$$I = I_d - I_L = I_0 [\exp(\frac{qV}{nkT}) - 1] - I_L$$
(1)

실리콘 솔라셀은 그림 9에서 전압이 0V일 때 -값의 전 류 값이 나타나고 0.7V이상이 되면 ITO 셀의 두께와 관 계없이 급격히 상승한다. 소자가 100 nm 길이이고 1 um 깊이이기 때문에 상대적으로 전류밀도는 23.2 mA/cm<sup>2</sup>, 28 mA/cm<sup>2</sup> 그리고 25.8 mA/cm<sup>2</sup>이다. 개방회로 전압  $V_{OC}$ 은 두께에서와 상관없이 모두 대략 0.94 V에서 만 들어진다.



전력은 셀 전류와 셀 전압의 곱이고 부하저항은 셀 전 압에서 셀 전류를 나누어 주면 된다 그림 10에서 보면 대 략 부하저항 32(Ω - cm<sup>2</sup>)에서 60 nm ITO셀이 22.0 mW/cm<sup>2</sup>로 전력이 가장 높게 나타났다. 이 최대 전력을 이용하여 곡선 인자를 구하면

$$\begin{split} FF &= \frac{V_m}{V_{OC}} [1 - \frac{\exp(\frac{qV_m}{nkT}) - 1}{\exp(\frac{qV_m}{nkT}) - 1}] \\ &= \frac{P_{\max}/cm^2}{J_{SC}V_{OC}} = \frac{22m\,W/cm^2}{28mA/cm^2\, \bullet \, 0.94\,V} = 0.83 \end{split}$$

솔라셀 기술에서 나오는 곡선 인자는 실제 최대 얻을 수 있는 전력의 비율로서 정의되어진다. 이 곡선 인자로 서 솔라셀의 성능을 판단할 수 있다. 대표적인 상업 솔라 셀은 곡선 인자가 0.7이상을 가지고 B급은 0.4~0.7이 나 타나는데 높을수록 솔라셀의 성능이 좋은 것이다.[4] 표 1은 위의 그래프들과 그림 10의 그래프를 표로 정리한 것이다. 여기서 파장 1은 투과율이 최대가 되는 파장을 나타내었고 파장 2는 전류가 최대가 되는 파장을 나타낸 것이다. 그리고 전류는 전압이 0V일 때 나타나는 전류의 크기이고, 전력과 외부 수집 효율성은 각 박막 두께에서 파장에 따라 나타나는 최고 수치이다. 표에서도 보이듯이 60 nm의 박막 두께에서 가장 우수한 특성들이 나타나고 있는 걸 보여주고 있다.



[그림 10] ITO 투명전극 두께에 따른 부하와 전력과의 관계

다음 표는 위의 그래프들을 표로 정리한 것이다. 여기 서 파장 1은 투과율이 최대가 되는 파장이고 파장 2는 전 류가 최대가 되는 파장을 나타낸 것이다.

[표 1] ITO 두께에 따른 솔라셀의 특징

	30 nm	60 nm	90 nm
파장1(nm)	340	540	750
파장2(nm)	600	600	660
전류(A)	$-2.32 \times 10^{-11}$	-2.8×10 <sup>-11</sup>	-2.58×10 <sup>-11</sup>
외부수집효율성	64%	90%	88%
전력( $mW/cm^2$ )	18	22	20
F.F	0.82	0.83	0.82

서 공정 전에 임의의 상태에서의 자동적인 I-V 곡선을 그 리는 것, 물리적인 성질을 나타내는 것이 가능한 프로그 램으로서 본 논문에서는 실리콘 솔라셀에 입사되는 파장 과 ITO의 두께에 따라 외부 수집 효율성, 투과율, I-V 특 성, 단락회로 전류에 대해서 비교 분석해 보았다. ITO박 막의 두께가 두꺼울수록 투과율이 최고점이 되는 파장은 커지고, 특정파장과 특정 두께에서 높은 효율과 전기적인 특성이 나타났다. 위에 실험 중 60 nm의 두께에서 가장 우수한 특성을 나타냈고 실제로 그렇게 나타날 것으로 생각된다. 곡선 인자 또한 0.83으로 상업적으로 사용되는 솔라셀보다 더 높게 나타났다. 본 해석결과는 솔라셀의 전기적 특성을 이해하고 좀 더 나은 솔라셀 제작을 위해 아주 유용하게 사용될 것으로 사료된다.

#### 참고문헌

- A.I. Stoller, The Etching of Deep Vertical Walled Pattern in Silicon (RCA Review, June 1970)
- [2] O.B. Lee, J. Appl. Phys, 1969, p.40.
- [3] 윤재호,김동호,권정대,임동찬, "박막형 태양전지 소재 기술", 녹색 소재 기술 특집 21권, 2009, pp.77
- [4] 이재형, 임동건, 이준신,, "태양전지 원론", 홍릉 과학 출판사,2005,pp.104~116
- [5] 이병인,류태규,한정만,최규하, "Preparation and Characterization of Transparent Conductive ITO Films by MOD Procss" 추계전력전자학술대회 논문집, 1998, pp.385~387

#### 김 재 규(Jae-Gyu Kim)

#### [정회원]



2004년 3월 ~ 현재 : 인제대학
 교 나노공학부(학부과정)

<관심분야> 반도체, 회로설계, 소자

#### 5. 결론

메디치 프로그램은 반도체 소자 공정 시뮬레이션으로

김 지 만(Ji-Man Kim)

[정회원]



- 2010년 2월 : 인제대학교 나노공 학부(공학사)
- 2010년 3월 ~ 현재 : 인제대학 교 나노시스템공학과 재학 중)

<관심분야> 반도체, 회로설계, 소자

#### 송 한 정(Han-Jung Song)

#### [정회원]



- 1986년 2월 : 한양대학교 전자공 학과(공학사))
- 1988년 2월 : 한양대학교 전자 공학과(공학석사)
- 2000년 2월 : 한양대학교 전자공 학과(공학박사)
- 2004년 3월 ~ 현재 : 인제대학 교 나노공학부 부교수

<관심분야> 반도체 소자 신뢰성 및 회로설계